物理学入門 第11回 電位と電気容量

2020年7月24日 担当:佐藤純

問題 1 x 軸原点に電荷 q がある.

(1-1) テスト電荷 q_t を, x = a から x = b まで運ぶのに必要な仕事 $W(a \rightarrow b)$ を求めよ. た だし, 0 < b < a とする.

クーロン力 $\frac{qq_t}{4\pi\epsilon_0x^2}$ に逆らって人間が加えなければならない力は, $-\frac{qq_t}{4\pi\epsilon_0x^2}$ である.したがって,

$$W(a \to b) = \int_a^b -\frac{qq_t}{4\pi\epsilon_0 x^2} dx = \frac{qq_t}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{1}{x} \right]_a^b = \boxed{\frac{qq_t}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{b} - \frac{1}{a} \right)}$$

(1-2) このとき,テスト電荷は仕事Wをされることによって,ポテンシャルエネルギーを蓄える.位置xにおけるポテンシャルエネルギーをU(x)とするとき,U(b)-U(a)を求めよ.

仕事をしてもらったことによって獲得したポテンシャルエネルギーは、

$$U(b) - U(a) = W(a \to b) = \boxed{\frac{qq_t}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{b} - \frac{1}{a}\right)}$$

である.

(1-3) ポテンシャルの基準点を x = a に選ぶ. すなわち, U(a) = 0 とする. このとき、位置 x におけるポテンシャルエネルギー U(x) を求めよ.

上式にU(a) = 0を代入して,

$$U(b) = \frac{qq_t}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{b} - \frac{1}{a} \right)$$

を得る. ここで、bをxに書き換えて、

$$U(x) = \frac{qq_t}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{a} \right)$$

を得る.

(1-4) ポテンシャルの基準点を無限遠点 $x=\infty$ に選んだときの,位置 x におけるポテンシャルエネルギー U(x) を求めよ.

$$\lim_{a \to \infty} \frac{1}{a} = 0$$

より,

$$U(x) = \frac{qq_t}{4\pi\epsilon_0 x}$$

を得る.

(1-5) 前問で求めたポテンシャルエネルギーを、テスト電荷 q_t で割ったもの $\phi(x) = U(x)/q_t$ を "電位"と呼ぶ、原点の電荷 q が位置 x に作る電位 $\phi(x)$ を求めよ、

$$\phi(x) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 x}$$

を得る.

(1-6) 位置 x における電場 E(x) は、電位 $\phi(x)$ を微分することによって

$$E(x) = -\phi'(x)$$

と書けることを確認せよ.

$$-\phi'(x) = -\left(\frac{q}{4\pi\epsilon_0 x}\right)' = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 x^2} = E(x)$$

(1-7) 同様にして、3次元の場合には、 \vec{r} の位置における電位 $\phi(\vec{r})$ は

$$\phi(\vec{r}) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}$$

と書ける. ただし, $r = |\vec{r}|$ は原点からの距離を表す.

 \vec{r} の位置における電場 $\overrightarrow{E}(\vec{r})$ は

$$\overrightarrow{E}(\vec{r}) = -\overrightarrow{\nabla}\phi$$

と書けることを示せ. ただし,

$$\overrightarrow{\nabla} = \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial y} \\ \frac{\partial}{\partial z} \end{pmatrix}, \qquad \overrightarrow{\nabla} \phi = \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial y} \\ \frac{\partial}{\partial z} \end{pmatrix} \phi = \begin{pmatrix} \frac{\partial \phi}{\partial x} \\ \frac{\partial \phi}{\partial y} \\ \frac{\partial \phi}{\partial z} \end{pmatrix}$$

である.

$$\vec{r} = (x, y, z), r = |\vec{r}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$
 とする.

まず,以下の微分式が成り立つことに注意.

$$\begin{split} \frac{\partial r}{\partial x} &= \frac{\partial}{\partial x} \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = \frac{\partial}{\partial x} (x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{1}{2}} \\ &= \frac{1}{2} (x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{1}{2} - 1} \frac{\partial}{\partial x} (x^2 + y^2 + z^2) \\ &= \frac{1}{2} (x^2 + y^2 + z^2)^{-\frac{1}{2}} (2x) \\ &= \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} = \frac{x}{r}, \end{split}$$

同様に $\frac{\partial r}{\partial y} = \frac{y}{r}$, $\frac{\partial r}{\partial z} = \frac{z}{r}$ が成り立つ. これを用いて,

$$\frac{\partial}{\partial x} \frac{1}{r} = \left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r} \frac{1}{r}\right) \frac{\partial r}{\partial x} = \left(-\frac{1}{r^2}\right) \frac{x}{r} = -\frac{x}{r^3}$$

同様に、
$$\frac{\partial}{\partial y} \frac{1}{r} = -\frac{y}{r^3}$$
、 $\frac{\partial}{\partial z} \frac{1}{r} = -\frac{z}{r^3}$ を得る. 以上により、
$$-\overrightarrow{\nabla}\phi = -\begin{pmatrix} \frac{\partial\phi}{\partial x} \\ \frac{\partial\phi}{\partial y} \\ \frac{\partial\phi}{\partial z} \end{pmatrix} = -\begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x} \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} \\ \frac{\partial}{\partial y} \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} \\ \frac{\partial}{\partial z} \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} \end{pmatrix} = -\frac{q}{4\pi\epsilon_0} \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x} \frac{1}{r} \\ \frac{\partial}{\partial y} \frac{1}{r} \\ \frac{\partial}{\partial z} \frac{1}{r} \end{pmatrix} = -\frac{q}{4\pi\epsilon_0} \begin{pmatrix} -\frac{x}{r^3} \\ -\frac{y}{r^3} \\ -\frac{z}{r^3} \end{pmatrix}$$

$$= \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^3} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^3} \overrightarrow{r} = \overrightarrow{E}.$$

を得る.

問題2 以下のコンデンサーの電気容量を求めよ.

(2-1) 平行平板コンデンサー (面積 S, 間隔 d)

z=0 の平板に電荷 +Q, z=d の平板に電荷 -Q があるとする.平板の電荷密度は $\sigma=\frac{Q}{S}$ なので,平板間の電場は

$$E = \frac{\sigma}{\epsilon_0} = \frac{Q}{\epsilon_0 S}$$

である (第11回の演習問題参照).

電場は z=0 の平板から発生し,z=d の平板に向かっている.したがって,z=0 の電位 $\phi(0)$ の方が z=d の電位 $\phi(d)$ よりも高い (正電荷を電場中に置くと,電位の高い方から低い方へと移動する).その電位差を V とする.すなわち,

$$V = \phi(0) - \phi(d)$$

である.

この電位差は,q=1のテスト電荷をz=dからz=0まで電場に逆らって (人間が) 運ぶのに必要な仕事 $W(d\to 0)$ に等しい (テスト電荷は人間から仕事 $W(d\to 0)$ をしてもらうことにより,その分ポテンシャルが増加する).

zにおける電場をE(z)とすると、それに逆らって人間が加えなければならない力は-E(z)である(負符号に注意!).

以上により、平板間の電位差Vは

$$V = \phi(0) - \phi(d) = W(d \to 0) = \int_{d}^{0} -E(z)dz = \frac{Qd}{\epsilon_0 S}$$

となる. これを Q について解くと

$$Q = \frac{\epsilon_0 S}{d} V$$

なので、Q = CV より電気容量 C は

$$C = \frac{\epsilon_0 S}{d}$$

となる.

(2-2) 同心球殻コンデンサー (半径 a, b)

半径aの球殻に電荷+Q,半径bの球殻に電荷-Qがあるとする (a < bとする).半径r (a < r < b) の球面Sで半径aの球殻を包むと,その内部の全電荷量はQ,Sの表面積は $4\pi r^2$ なので,ガウスの定理より

$$E(r)4\pi r^2 = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

が成り立つので,

$$E(r) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

を得る. 前間と同じ考え方により, 球殻間の電位差は

$$V = \phi(a) - \phi(b) = W(b \to a) = \int_{b}^{a} -E(r) dr$$

$$= \frac{Q}{4\pi\epsilon_{0}} \int_{b}^{a} \left(-\frac{dr}{r^{2}}\right)$$

$$= \frac{Q}{4\pi\epsilon_{0}} \left[\frac{1}{r}\right]_{b}^{a}$$

$$= \frac{Q}{4\pi\epsilon_{0}} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b}\right)$$

$$= \frac{Q(b-a)}{4\pi\epsilon_{0}ab}$$

なので、Q = CV より電気容量 C は

$$C = \frac{4\pi\epsilon_0 ab}{b-a}$$

となる.

(2-3) 同軸円筒コンデンサー (半径a,b, 長さ ℓ)

半径 a の円筒に電荷 +Q,半径 b の円筒に電荷 -Q があるとする (a < b とする).半径 r (a < r < b) の円筒 S で半径 a の円筒を包むと,その内部の全電荷量は Q,S の側面積は $2\pi r\ell$ なので,ガウスの定理より

$$E(r)2\pi r\ell = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

が成り立つので,

$$E(r) = \frac{Q}{2\pi\epsilon_0 r\ell}$$

を得る. 前問と同じ考え方により, 球殻間の電位差は

$$\begin{split} V &= \phi(a) - \phi(b) = W(b \to a) = \int_b^a -E(r) \mathrm{d}r \\ &= \frac{Q}{2\pi\epsilon_0 \ell} \int_b^a \left(-\frac{\mathrm{d}r}{r} \right) \\ &= \frac{Q}{2\pi\epsilon_0 \ell} \left[-\log r \right]_b^a \\ &= \frac{Q}{2\pi\epsilon_0 \ell} \log \frac{b}{a} \end{split}$$

なので、Q = CV より電気容量 C は

$$C = 2\pi\epsilon_0 \ell \left(\log \frac{b}{a}\right)^{-1}$$

となる.